

	<h2 style="color: #E67E22;">SIHJ10N60E-T1-GE3</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: SIHJ10N60E-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 10A SO8
	Datenblätter:  SIHJ10N60E-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	


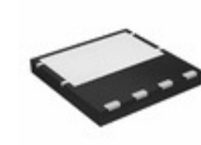

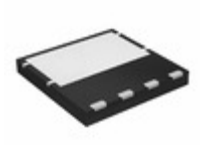

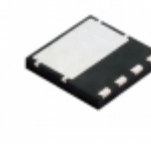
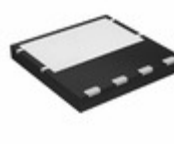

Spezifikationen

Teilenummer	SIHJ10N60E-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	89W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	784pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

SIHJ10N60E-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHJ10N60E-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHJ10N60E-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHJ10N60E-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SIHJ10N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 10A POWERPAKSO	 SIHH27N60EF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A POWERPAK8	 SIHJ6N65E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L	 SIHH28N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A POWERPAK8
 SIHJ6N65E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L	 SIHH26N60EF-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 600V 24A POWERPAK	 SIHH26N60EF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V 24A POWERPAK	 SIHJ240N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V PPAK SO- 8L

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHJ10N60E-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIHJ10N60E-T1-GE3 Datenblatt	SIHJ10N60E-T1-GE3-Datenblätter	SIHJ10N60E-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHJ10N60E-T1-GE3
SIHJ10N60E-T1-GE3 Electronic	SIHJ10N60E-T1-GE3-Komponenten	SIHJ10N60E-T1-GE3-Verteiler	SIHJ10N60E-T1-GE3-Bild	SIHJ10N60E-T1-GE3-Teil
SIHJ10N60E-T1-GE3 Preis	SIHJ10N60E-T1-GE3 Hersteller	SIHJ10N60E-T1-GE3 Bild	SIHJ10N60E-T1-GE3 Aktie	SIHJ10N60E-T1-GE3 Inventar
SIHJ10N60E-T1-GE3 Neu	SIHJ10N60E-T1-GE3 Original	SIHJ10N60E-T1-GE3 garantiert	SIHJ10N60E-T1-GE3 RFQ	SIHJ10N60E-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited